Глазов Михаил Михайлович



член отделения РАН - Отделение физических наук

член секции РАН - Секция общей физики и астрономии

член совета СПбО РАН - Объединённый научный совет по естественным наукам (ОНС ЕН)

член бюро совета СПбО РАН - Бюро ОНС ЕН

учёный секретарь секции СПбО РАН - Секция физических наук ОНС ЕН

Академическое звание: член-корреспондент РАН

Почетное звание: профессор РАН

Ученая степень: доктор физико-математических наук

Общая информация

Научные интересы

Теория конденсированных сред, транспортных, оптических и спиновых явлений в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах.

Научные публикации

- M.M. Glazov and E.L. Ivchenko, Precession Spin Relaxation Mechanism Caused by Frequent Electron–Electron Collisions. JETP Lett. 75, 403 (2002).
- A.V. Kavokin, G. Malpuech, M.M. Glazov, Optical Spin Hall Effect, Phys. Rev. Lett. 95, 136601 (2005).
- C. Leyder, M. Romanelli, J. Ph. Karr, E. Giacobino, T. C. H. Liew, M. M. Glazov, A. V. Kavokin, G. Malpuech, and A. Bramati, Observation of the optical spin Hall effect, Nature Physics 3, 628-631 (2007).
- M.M. Glazov, S.D. Ganichev, High frequency electric field induced nonlinear effects in graphene, Physics Reports 535, 101-138 (2014).
- Gang Wang, Alexey Chernikov, Mikhail M. Glazov, Tony F. Heinz, Xavier Marie, Thierry Amand, and Bernhard Urbaszek, Colloquium: Excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides, Rev. Mod. Phys. 90, 021001 (2018).
- M.M. Glazov, «Electron & Nuclear Spin Dynamics in Semiconductor Nanostructures, » Series on Semiconductor Science and Technology, Oxford University Press Oxford, 2018.
- М. В. Дурнев, М. М. Глазов, Экситоны и трионы в двумерных полупроводниках на основе дихалькогенидов переходных металлов, УФН 188, 913–934 (2018).
- М. М. Глазов, Р. А. Сурис, Коллективные состояния экситонов в полупроводниках, УФН 190-11-21–1142 (2020).
- Д. С. Смирнов, В. Н. Манцевич, М. М. Глазов, Теория оптически детектируемых спиновых флуктуаций в наносистемах, УФН 191, 973–998 (2021).
- M.M. Glazov, Optical properties of charged excitons in two-dimensional semiconductors J. Chem. Phys. 153, 034703 (2020).

Премии и награды

- Медаль РАН с премией для молодых ученых, 2014 г.
- Премия им. Л. Эйлера Правительства Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН, 2015 г.

Место работы и должность

ФГБУН Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук, ведущий научный сотрудник.

Персональные профили исследователя

РИНЦ ID 2423-2072
Scopus ID 16229866100
Web of Science Researcher ID I-7768-2013
Orcid ID 0000-0003-4462-0749